



NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



MICROWAVE CORPORATION

v01.0113



HMC3653LP3BE

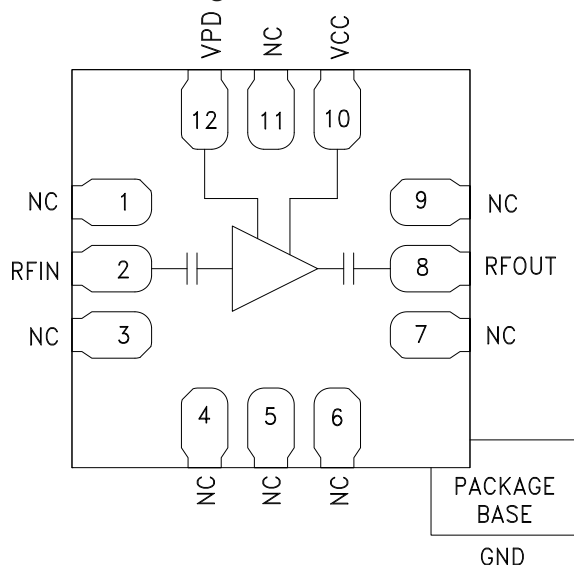
HBT GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER, 7 - 15 GHz

Typical Applications

The HMC3653LP3BE is ideal for:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multipoint Radios
- VSAT
- LO Driver for HMC Mixers
- Military EW & ECM

Functional Diagram



Features

- High Output IP3: +28 dBm
- Single Positive Supply: +5V
- Low Noise Figure: 4.0 dB ^[1]
- 12 Lead 3x3 mm SMT Package: 9mm²

General Description

The HMC3653LP3BE is a HBT Gain Block MMIC amplifier covering 7 GHz to 15 GHz and packaged in a 3x3 mm plastic QFN SMT package. This versatile amplifier can be used as a cascadable IF or RF gain stage in 50 Ohm applications. The HMC3653LP3BE delivers 15 dB gain, and +15 dBm output P1dB with only 4 dB noise figure.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5V$, $V_{PD} = 5V$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	7 - 9			9 - 14			14 - 15			GHz
Gain ^[1]	10.5	14		12	15		12	15		dB
Gain Variation Over Temperature		0.016			0.016			0.022		dB / °C
Input Return Loss		14			15			11		dB
Output Return Loss		8			8			7		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB) ^[1]	13	16		12	15		10.5	13.5		dBm
Output Third Order Intercept (IP3) (Pout = 0 dBm per tone, 1 MHz spacing)		26			28			26		dBm
Noise Figure ^[1]		6			4			4		dB
Supply Current 1 (Idd1)		40	55		40	55		40	55	mA
Supply Current 2 (Idd2)		4	6		4	6		4	6	mA

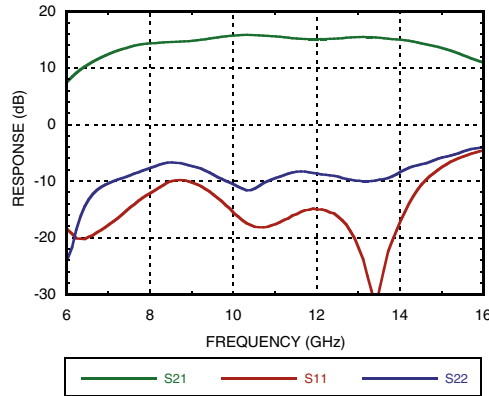
[1] Board loss subtracted out

For price, delivery and to place orders: Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824

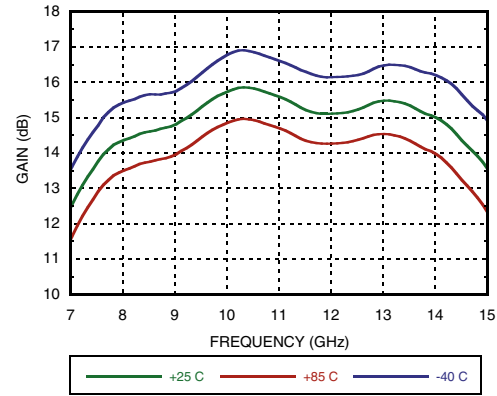
Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373 Order On-line at www.hittite.com

Application Support: Phone: 978-250-3343 or apps@hittite.com

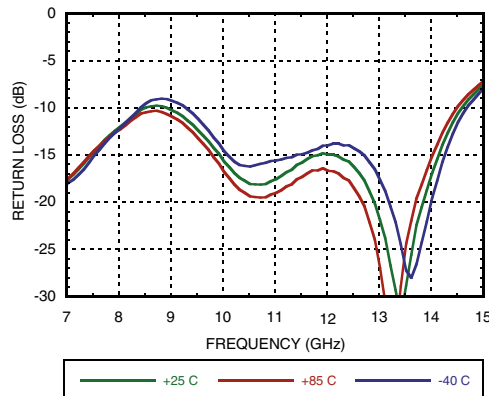
Gain & Return Loss



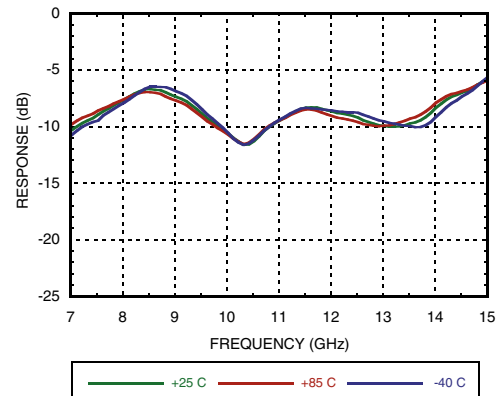
Gain vs. Temperature



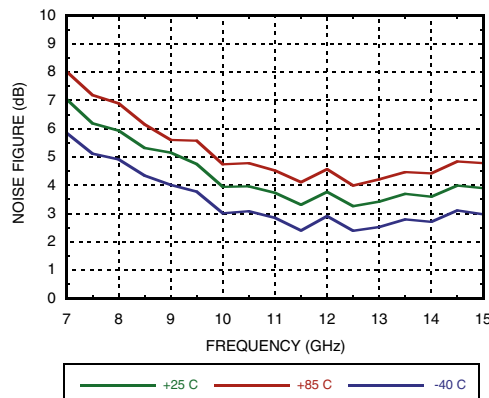
Input Return Loss vs. Temperature



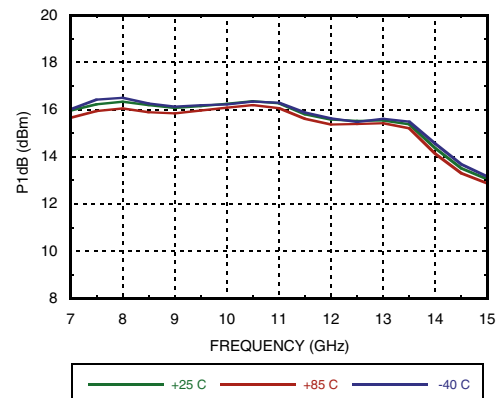
Output Return Loss vs Temperature



Noise Figure vs. Temperature



P1dB vs. Temperature



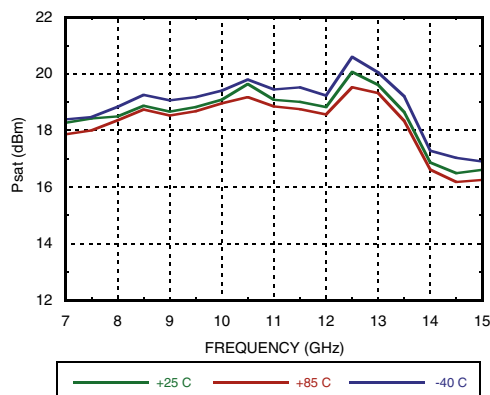


v01.0113

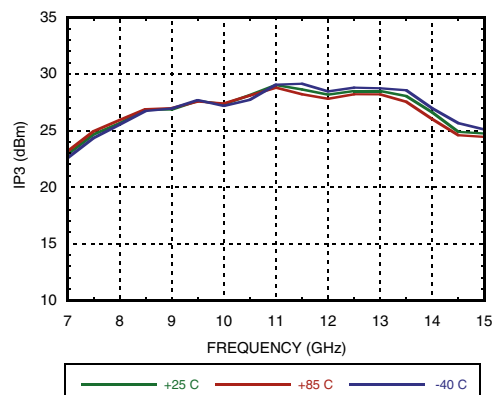
HMC3653LP3BE

HBT GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER, 7 - 15 GHz

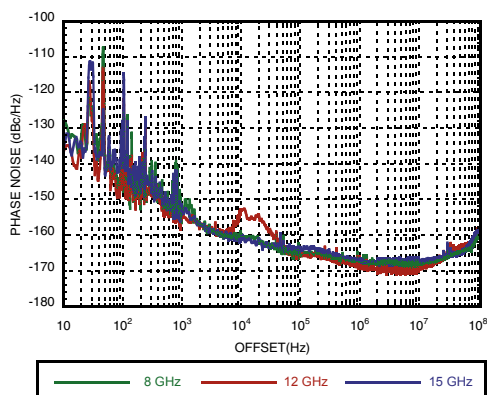
Psat vs. Temperature



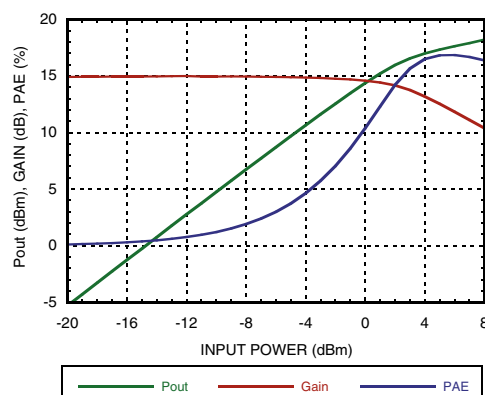
Output IP3 vs Temperature



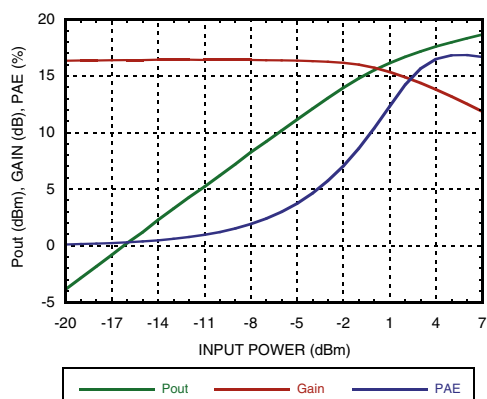
Phase Noise @ Pin=0 dBm



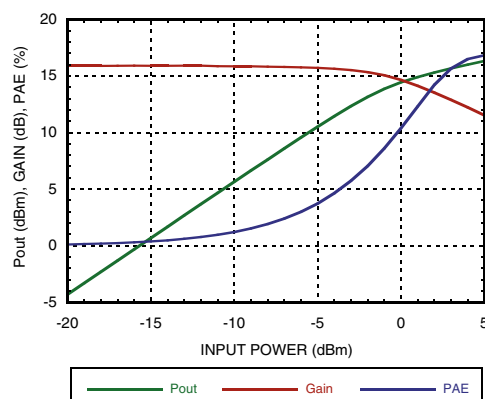
Power Compression @ 8 GHz



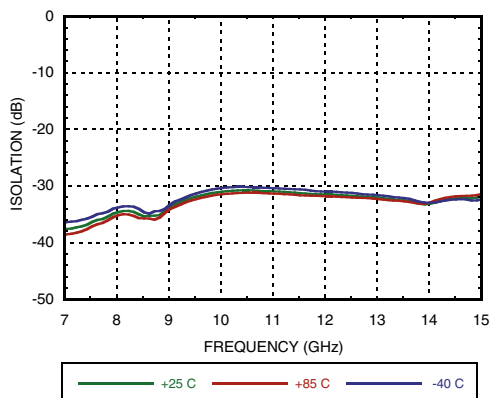
Power Compression @ 11 GHz



Power Compression @ 14 GHz



Reverse Isolation



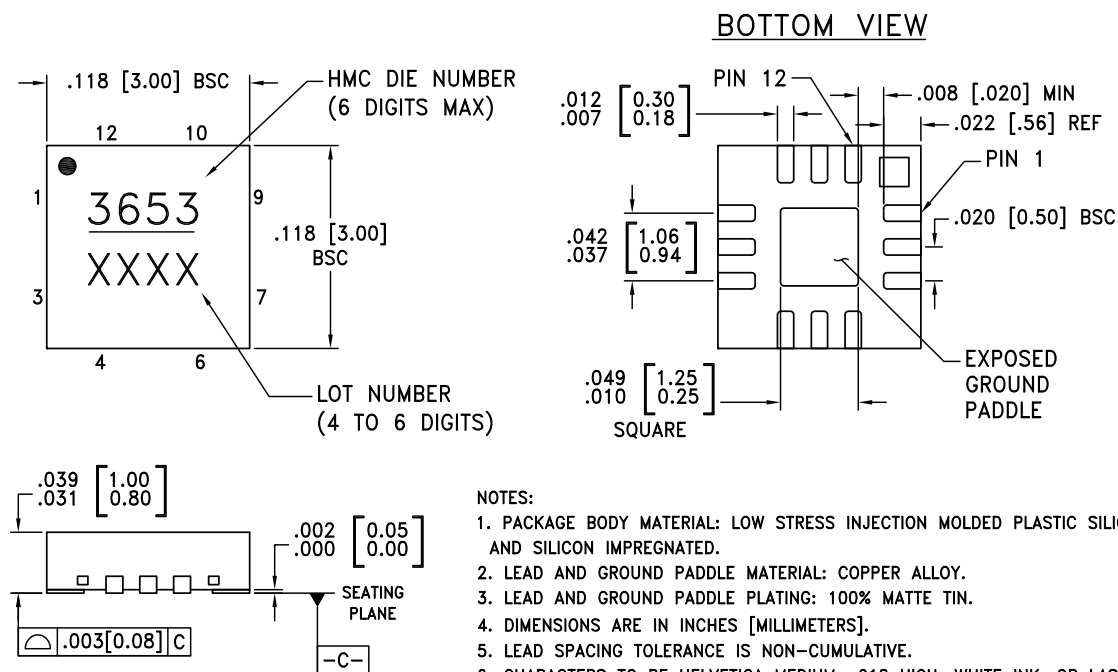
Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage	6 Vdc
RF Input Power (RFIN)	+12 dBm
Channel Temperature	150 °C
Continuous P _{diss} (T=85 °C) (derate 7.87 mW/ °C Above +85 °C)	512 mW
Thermal Resistance (channel to ground paddle)	127 °C/W
Storage Temperature	-65 to 150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

HMC3653LP3BE

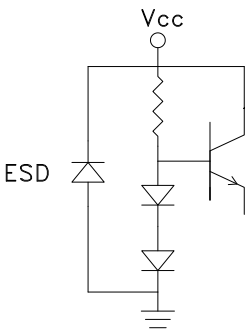
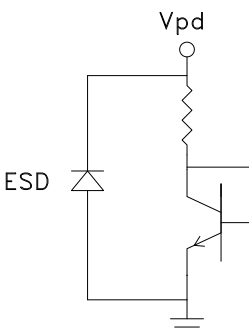
HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, 7 - 15 GHz
Outline Drawing**Package Information**

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating ^[2]	Package Marking ^[1]
HMC3653	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1	H3653 XXXX

[1] 4-Digit lot number XXXX

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

Pin Descriptions

Pid Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11	NC	No connection necessary. These pins may be connected to RF/DC ground. Performance will not be affected.	
2	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	RFIN ○ — —
8	RFOUT	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	— — ○ RFOUT
10	Vcc	Power supply voltage for the amplifier	
12	Vpd	Power Control Pin for proper control bias	
GND Paddle	GND	Ground Paddle must be connected to RF/DC ground.	



MICROWAVE CORPORATION

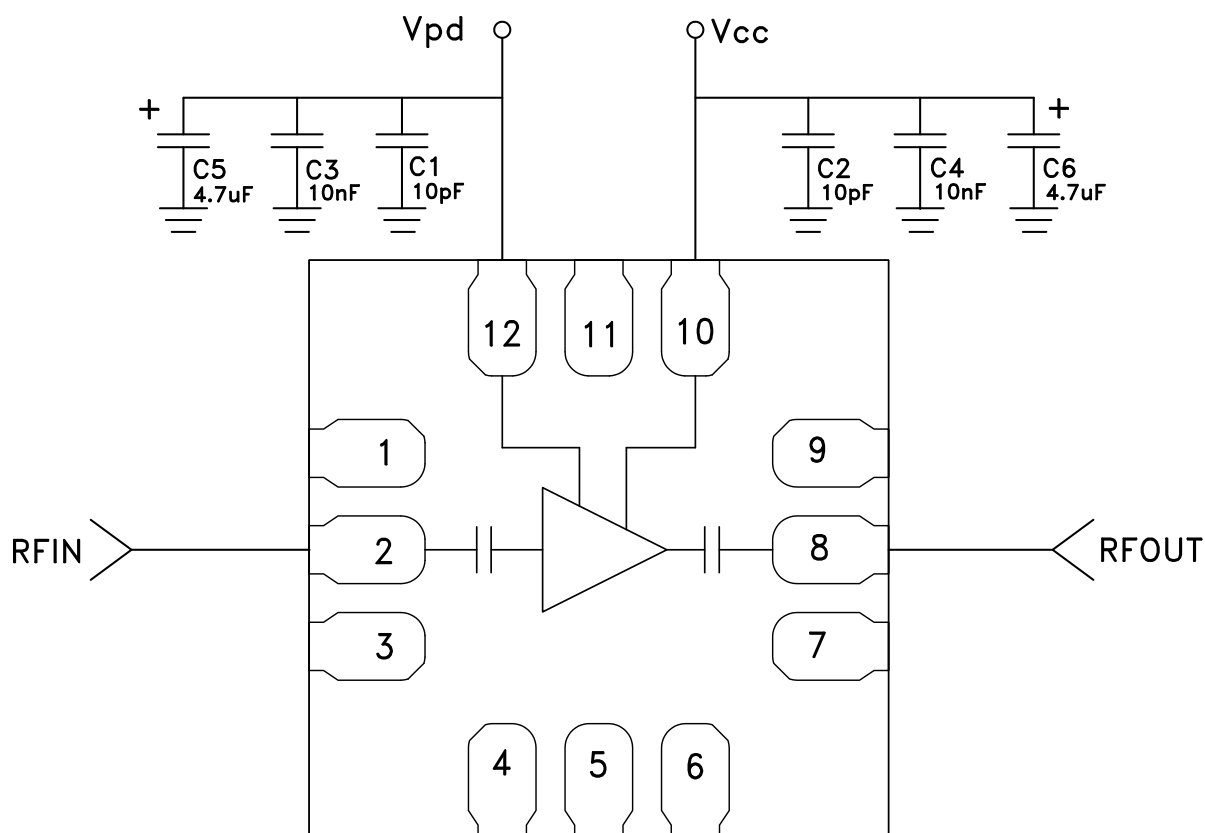
v01.0113



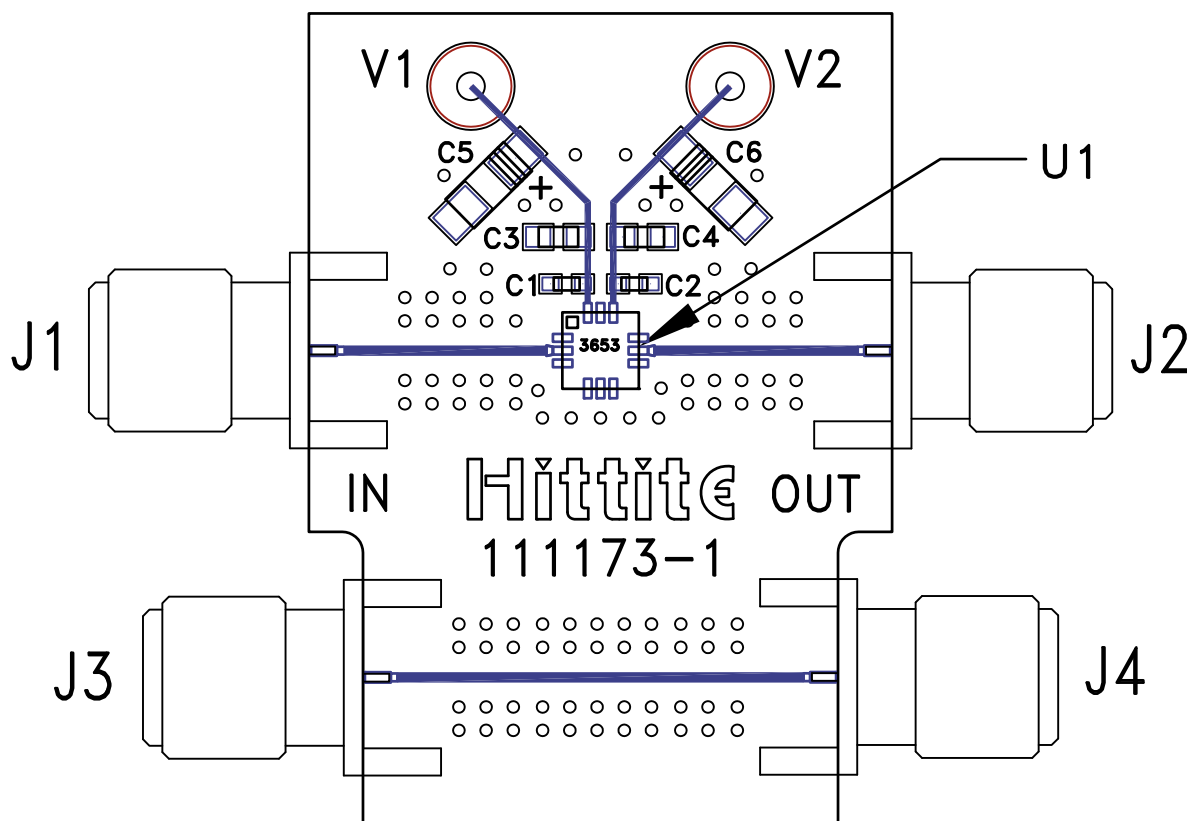
HMC3653LP3BE

HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, 7 - 15 GHz

Application Circuit



Evaluation PCB



List of Material for Evaluation PCB 113589-HMC3653LP3B-rev D ^[1]

Item	Description
J1, J4	PCB Mount SMA RF Connector
C1 - C2	10 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C3 - C4	10000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C5 - C6	4.7 uF Capacitor, Tantalum.
U1	HMC3653LP3BE
PCB ^[2]	111173-1 Evaluation Board

^[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

^[2] Circuit Board Material: Rogers 4350 or Arlon 25FR

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331